

Электронные свойства полупроводников

Банная В.Ф., Никитина Е.В.

Разогрев электронов в чистом Ge в квантовом магнитном поле при термическом возбуждении носителей заряда

221

Мохов Е.Н., Рабчинский М.К., Нагалюк С.С., Гафуров М.Р., Казарова О.П.

Влияние акцепторной примеси бериллия на оптические свойства монокристаллического AlN

224

Немов С.А., Улашкевич Ю.В., Погумирский М.В., Степанова О.С.

Отражение от боковой грани кристалла PbSb₂Te₄

228

Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Григорьев Л.В., Морозов И.С., Журавлев Н.В., Семенов А.А., Никитин А.А.

Фотолюминесцентные и фотоэлектрические свойства тонкопленочной структуры ZnO-LiNbO₃ в ультрафиолетовом и видимом диапазонах спектра

232

Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Григорьев М.В., Казарян Д.А., Вдовин Е.Е., Ханин Ю.Н., Морозов С.В., Новоселов К.С.

Роль структурных несовершенств графена в резонансном туннелировании через локализованные состояния в h-BN барьере ван-дер-ваальсовых гетероструктур

238

Badr A.M., Afify H.H., Shaker Sh.E., Elshaikh H.A.

Characteristics of DC Electrical Conductivity and Optoelectronic Features of Tin Dioxide Nanocrystals Synthesized by Sol-Gel Chemistry

244

Misra K.P., Jain S., Agarwala A., Halder N., Chattopadhyay S.

Effective Mass Model Supported Band Gap Variation in Cobalt-Doped ZnO Nanoparticles Obtained by Co-precipitation

245

Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Желаннов А.В., Ионов А.С., Селезнев Б.И., Федоров Д.Г.

Омические контакты к приборным структурам на основе нитрида галлия

246

Fan Zhang, Кочубей С.А., Stoffel M., Rinnert H., Vergnat M., Володин В.А.

Формирование аморфных нанокластеров и нанокристаллов германия в пленках GeSi_xO_y на кварцевой подложке с использованием печных и импульсных лазерных отжигов

251

Бачериков Ю.Ю., Ворона И.П., Охрименко О.Б., Кладько В.П., Жук А.Г., Окулов С.М., Полищук Ю.О., Гильчук А.В., Романенко Ю.М., Кидалов В.В.

Кластеризация марганца в ZnS : Mn, Mg, полученного методом высокотемпературного самораспространяющегося синтеза

259

Физика полупроводниковых приборов

Торхов Н.А., Новиков В.А.

Исследование электростатической системы поверхности кристаллов AuNi/GaN диодов Шоттки методом зонда Кельвина атомно-силовой микроскопии

266

Иванов М.С., Подольская Н.И., Родин П.Б. Двойная лавинная инжекция в диодных лавинных обострителях	275
Морозов К.М., Белоновский А.В., Гиршова Е.И., Иванов К.А., Калитеевский М.А. Свойства микрорезонатора на основе таммовского плазмона с внутрирезонаторными металлическими слоями и органической активной областью	280
Калиновский В.С., Контрош Е.В., Климко Г.В., Иванов С.В., Юферев В.С., Бер Б.Я., Казанцев Д.Ю., Андреев В.М. Разработка и исследование туннельных р-і-п-диодов GaAs/AlGaAs для многопереходных преобразователей мощного лазерного излучения	285
Асланян А.Э., Авакянц Л.П., Червяков А.В., Туркин А.Н., Курешов В.А., Сабитов Д.Р., Мармалюк А.А. Фотореверсивный ток в светодиодных гетероструктурах на основе InGaN/GaN с разным количеством квантовых ям	292
Зубов Ф.И., Муретова М.Е., Паюсов А.С., Максимов М.В., Жуков А.Е., Асрян Л.В. Паразитная рекомбинация в лазере с асимметричными барьерными слоями	296
Chaudhary Preeti, Kumar Vipin Synthesis and Characterization of Sol-Gel Screen Printed Gd : ZnO (GZO) Film towards Opto-Electronic Applications	304
Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур Шупенев А.Е., Коршунов И.С., Григорьянц А.Г. Получение тонких пленок теллурида висмута на полиимидных подложках методом импульсного лазерного осаждения	305
Ложкина Д.А., Румянцев А.М., Астрова Е.В. Импедансная спектроскопия пористых кремниевых и кремний-углеродных анодов, полученных спеканием	310